高分子太陽電池における界面 CT 励起子の解離機構

Charge Dissociation from Interfacial CT Excitons in Polymer Solar Cells

京大院工¹,^O奥山 拓夢¹,玉井 康成¹,大北 英生¹,辨天 宏明¹,伊藤 紳三郎¹

Kyoto Univ.¹, [°]Takumu Okuyama¹, Yasunari Tamai¹, Hideo Ohkita¹, Hiroaki Benten¹, Shinzaburo Ito¹ E-mail: okuyama@photo.polym.kyoto-u.ac.jp

[緒言] 高分子太陽電池では電子ドナー/アクセプター界面において、光励起により生じた励起子は、緩和した界面電荷移動 (CT)状態を経て、あるいは余剰エネルギーを保持した非緩和 状態から自由電荷へ解離すると考えられている。これまでの研 究では、ポリマー吸収帯を励起することで励起子からの電荷解 離過程を観測しており、界面 CT 状態が電荷解離にどのように 関与しているか十分に理解されていない。本研究では、ドナー

に regiorandom poly(3-hexylthiophene) (RRa-P3HT, 図 1a)、 アクセプターに [6,6]-phenyl-C₆₁-butyric acid methyl ester (PCBM, 図 1b)を用いたドロップキャスト膜に対して、CT 吸収 帯を直接励起することで、CT 励起子の余剰エネルギーと電荷 解離効率(η_{CD})の関係を評価した。

[実験] クロロベンゼンに RRa-P3HT と PCBM を重量比 1:1 で 溶解した。得られた溶液をガラス基板上にドロップキャストする ことで厚さ数 µm のブレンド膜を作製した。得られた厚膜に対 してポリマー吸収帯(3.1 eV)から CT 吸収帯(1.41 eV)まで励起 波長を変えて過渡吸収測定を行った。

[結果と考察] RRa-P3HT/PCBM ブレンド膜を励起波長 400 nm (3.1 eV)で励起することで得た過渡吸収スペクトル を図2に示す。励起直後に見られる 1100 nm 付近の吸収 帯は一重項励起子に帰属されている。一重項励起子の減 衰後には 800 nm と 2000 nm に吸収帯を持つ CT 励起子の みが観測された。今回、他の過渡種と吸収帯が重ならな い 2000 nm の波長を用いて CT 励起子のダイナミクスを評 価した。減衰成分はいずれの励起波長でも時定数約1ns 程度で励起光強度依存を示さなかったため、CT 状態から の対再結合により失活することがわかった。ナノ秒領域 でも減衰せず残っている成分は CT 状態から電荷解離す ることで生じた自由電荷と考えられる。図3にCT準位 (1.58 eV)と励起エネルギーの差に対して電荷解離効率を プロットしたものを示す。自由電荷への解離効率は、 RRa-P3HT または PCBM 吸収帯励起では2 割程度で一定 であるものの、CT 吸収帯励起では励起エネルギーの低下 とともに減少することがわかった。これは、緩和 CT 状 態に近づくにつれ電荷解離効率が大幅に低下することを 示す。以上の結果より、この系では緩和 CT 状態からの 自由電荷解離は起こらず、余剰エネルギーを持った非緩 和状態からのみ自由電荷が生成することがわかった。



Figure 1. Chemical structures of a) RRa-P3HT and b) PCBM.



Figure 2. Transient absorption spectra of a RRa-P3HT/PCBM film measured at 0 (black), 1 (red) and 5000 ps (blue) after the photoexcitation.



Figure 3. Free charge dissociation efficiency of the RRa-P3HT/PCBM film plotted against the energy difference between the excitation photon energy (upper) and the CT state. The hatching area indicates the RRa-P3HT or PCBM absorption region.